

Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	0 /48

PK35 Device Structure

Rev.1.0

PHENITEC SEMICONDUCTOR Corp.

Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	1 /48

Contents

1. About Layout pattern and Dark/Clear

2. Device Cross section

MPM(**5V** Pch Medium Vt)
 MPL(**5V** Pch Low Vt)
 MPL2(**5V** Pch very Low Vt)
 MPN(**5V** Pch Native Vt)
 MPMI(**5V** Pch Medium Vt Iso)
 MPLI(**5V** Pch Low Vt Iso)
 MPL2I(**5V** Pch very Low Vt Iso)
 MPNI(**5V** Pch Native Vt Iso)
 MNM(**5V** Nch Medium Vt)
 MNH(**5V** Nch High Vt)
 MNL(**5V** Nch Low Vt)
 MND(**5V** Nch Depletion Vt)
 MNN(**5V** Nch Native Vt)
 MNE_LC, MNE_PC(**5V** Nch Esd protection/8finger, 10finger)
 MNMI(**5V** Nch Medium Vt Iso)
 MNHI(**5V** Nch High Vt Iso)
 MNLI(**5V** Nch Low Vt Iso)
 MNDI(**5V** Nch Depletion Vt Iso)
 MNNI(**5V** Nch Native Vt Iso)
 MNEI_LC, MNEI_PC(**5V** Nch Esd protection Iso/8finger, 10finger)
 RPL(Low Resistance Poly-Si Resistor【95Ω/s】)
 RPM(Medium Resistance Poly-Si Resistor【330Ω/s】)
 RPH, RPH2(High Resistance Poly-Si Resistor【5kΩ/s】, 【8kΩ/s】)
 RNW(Nwell Diff. Resistor)
 RN(N+ Diff. Resistor)
 RP(P+ Diff. Resistor)
 CPIP(PIP Capacitor)
 CND(Nch Depletion Vt Capacitor)
 CNDI(Iso Nch Depletion Vt Capacitor)
 CPL2(Pch Very Low Vt Capacitor)
 CPL2I(Iso Pch Very Low Vt Capacitor)
 PNP(Vertical PNP (P+/Nwell/Psub))
 PNP2(Vertical PNP (P+/Nwell+DNW/Psub))
 NPN(Vertical NPN (N+/Pwell/DNW))
 RFS(Poly-Si Laser Trimming Fuse)
 DP(P+/Nwell Diode)
 DP2(P+/Nwell in Niso Diode)
 DN(N+/Pwell Diode)
 DN2(N+/Pwell in Niso Diode)
P (3.3V Pch MOS)
N (3.3V Nch MOS)

3. Fuse Opening-part Cross section

4. Relation between Mask and Implant for CRP (1st Poly-Si)

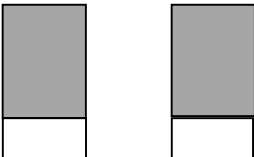
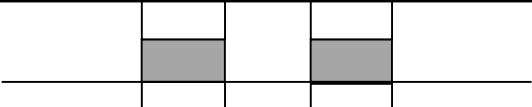

5. Revision History

Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	2 /48

1. About Layout pattern and Dark/Clear

2

下記にレイアウトデータとマスクの概念を示します。

レイアウトデータ		
マスクパターン	正	
	反	

Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	3 /48

2. Device Cross section

MPM(5V Pch Medium Vt)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18	-		
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

NWELL

AA

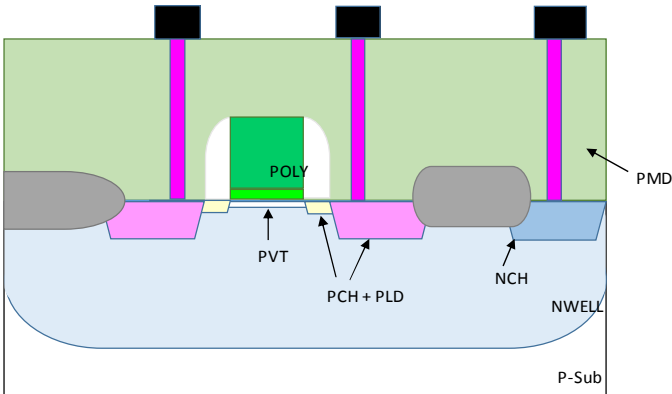
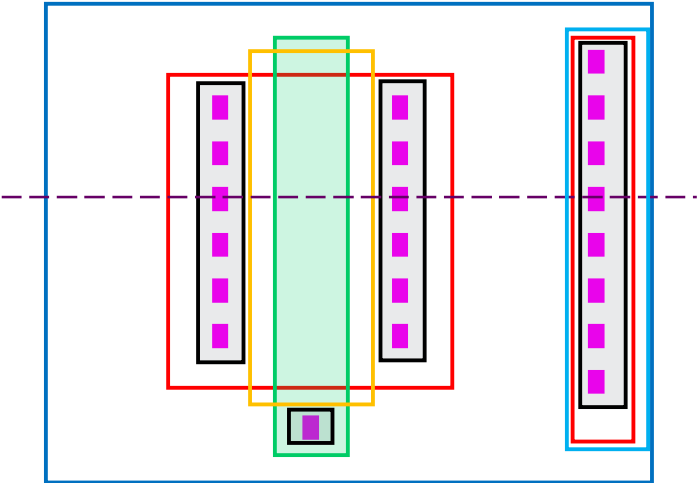
PVT

POLY

NCH+NLD

CONT

1METAL

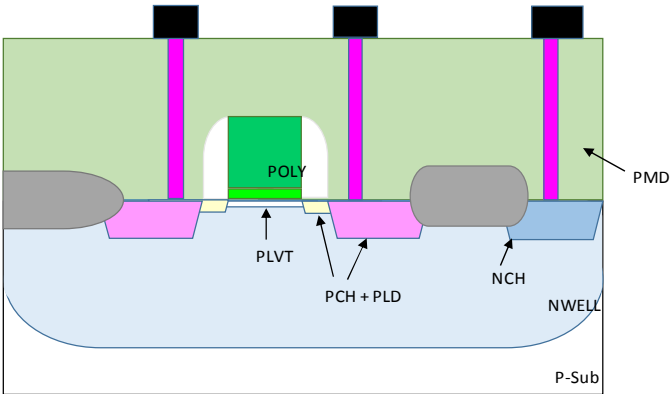
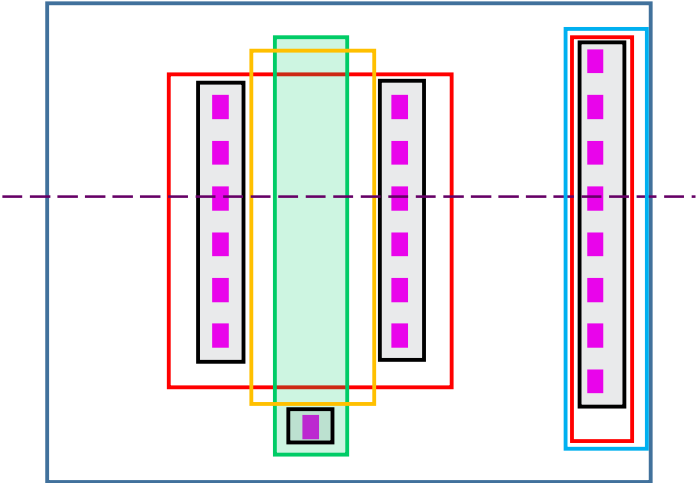


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	4 /48

MPL(5V Pch Low Vt)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18	-		
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

NWELL
AA
PLVT
POLY
NCH+NLD
CONT
1METAL

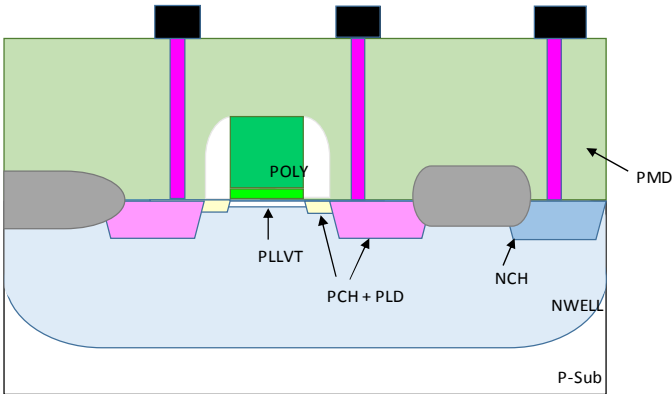
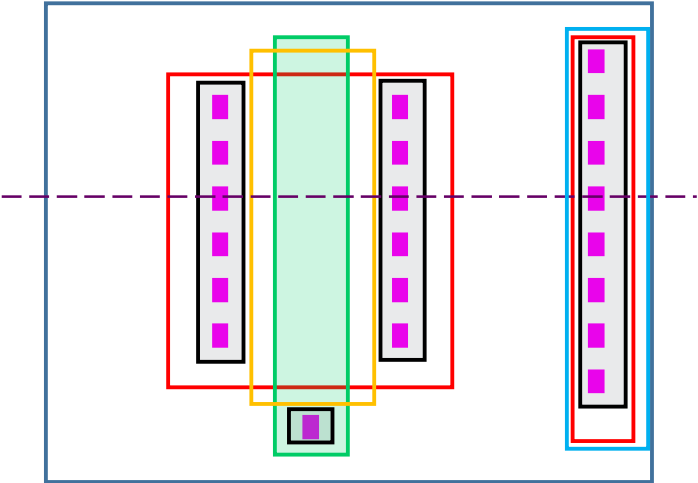


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	5 /48

MPL2(5V Pch very Low Vt)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18	-		
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

- NWELL
- AA
- PLLVT
- POLY
- NCH+NLD
- CONT
- 1METAL

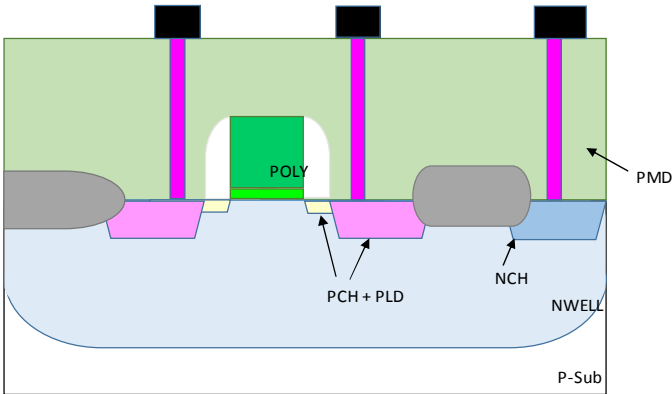
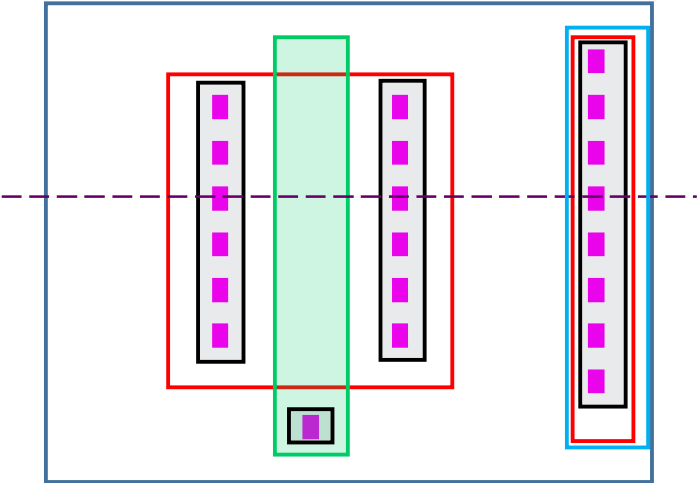


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	6 /48

MPN(5V Pch Native Vt)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18	-		
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

- NWELL
- AA
- POLY
- NCH+NLD
- CONT
- 1METAL

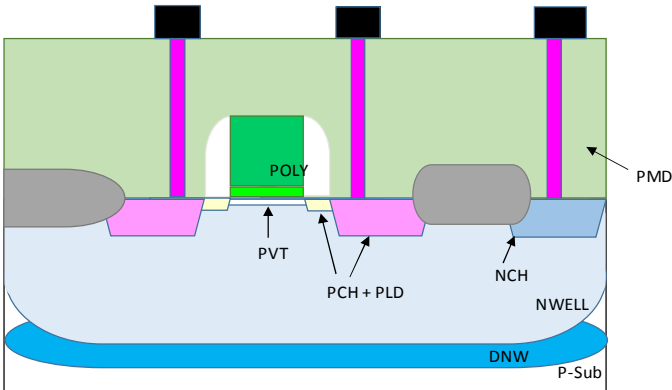
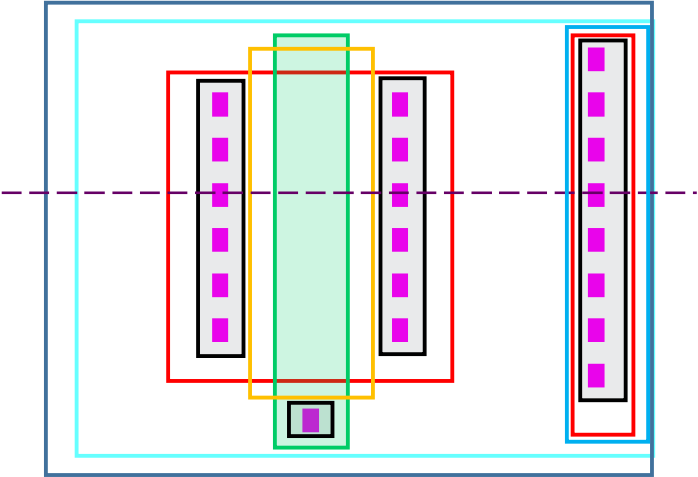


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	7 /48

MPMI(5V Pch Medium Vt Iso)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18	-		
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

- DNW
- NWELL
- AA
- PVT
- POLY
- NCH+NLD
- CONT
- 1METAL

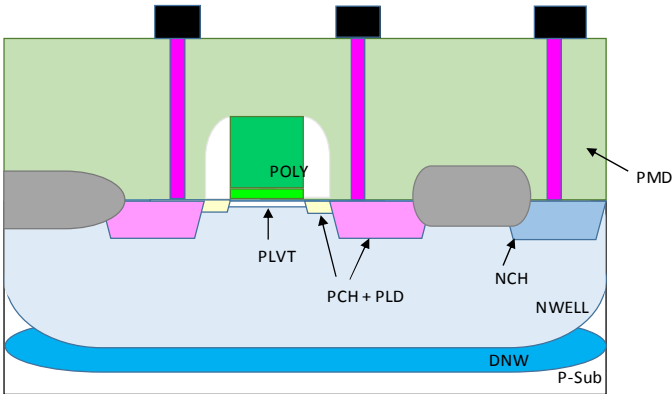
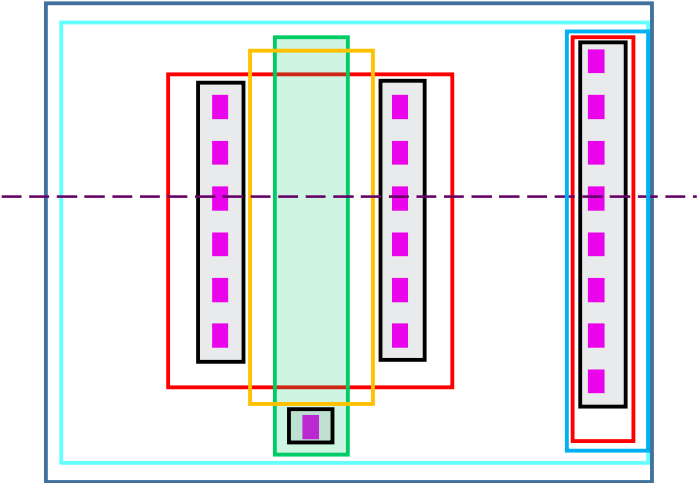


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	8 /48

MPLI(5V Pch Low Vt Iso)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18	-		
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

- DNW
- NWELL
- AA
- PLVT
- POLY
- NCH+NLD
- CONT
- 1METAL

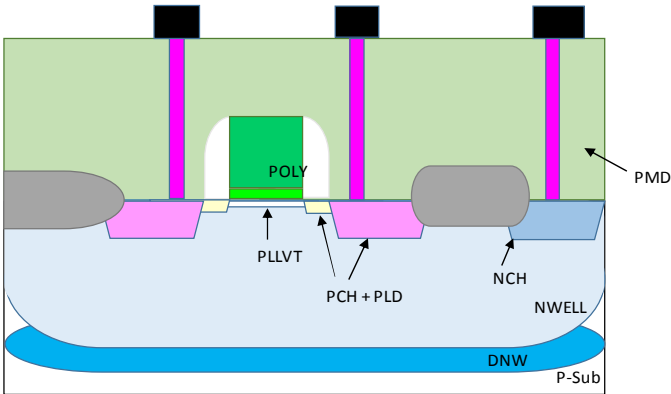
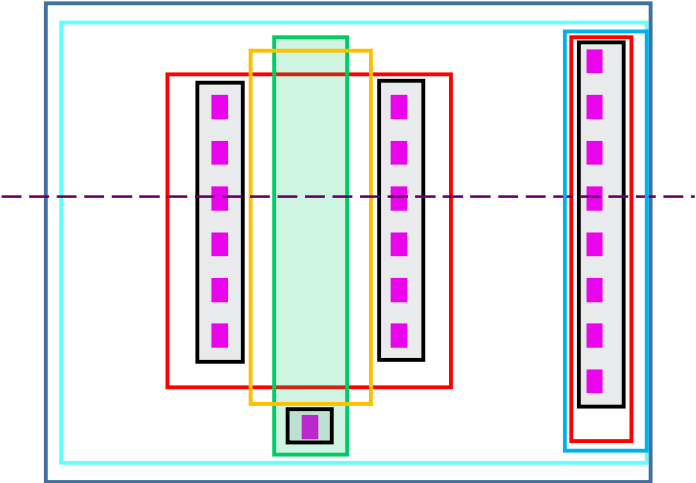


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	9 /48

MPL2I(5V Pch very Low Vt Iso)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18	-		
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

- DNW
- NWELL
- AA
- PLLVT
- POLY
- NCH+NLD
- CONT
- 1METAL

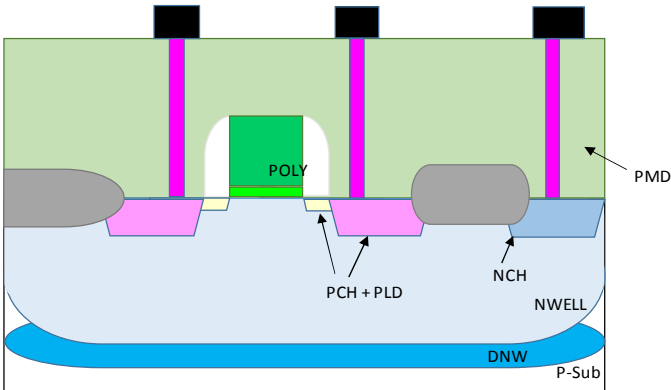
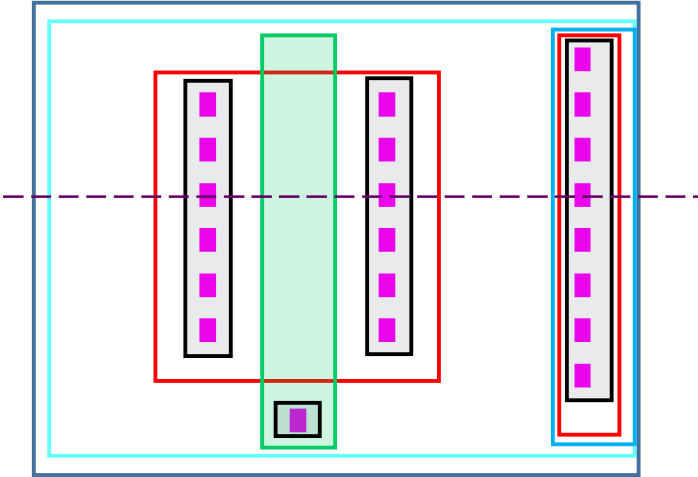


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	10 /48

MPNI(5V Pch Native Vt Iso)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18	-		
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

DNW
NWELL
AA
POLY
NCH+NLD
CONT
1METAL

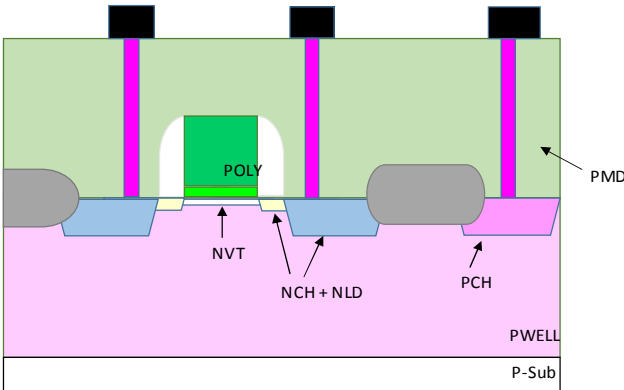
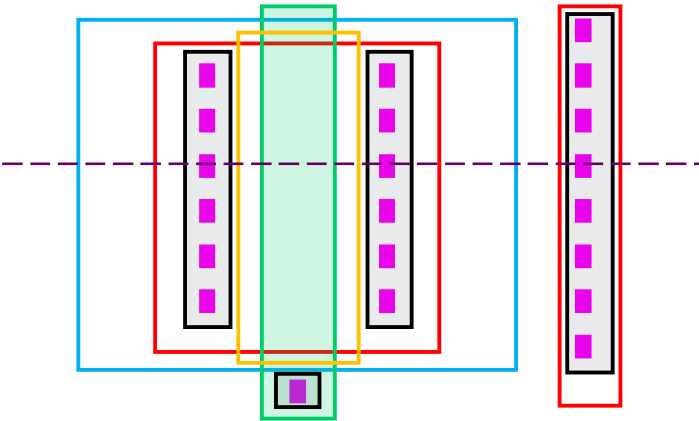


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	11 /48

MNM(5V Nch Medium Vt)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

- AA
- NVT
- POLY
- NCH+NLD
- CONT
- 1METAL

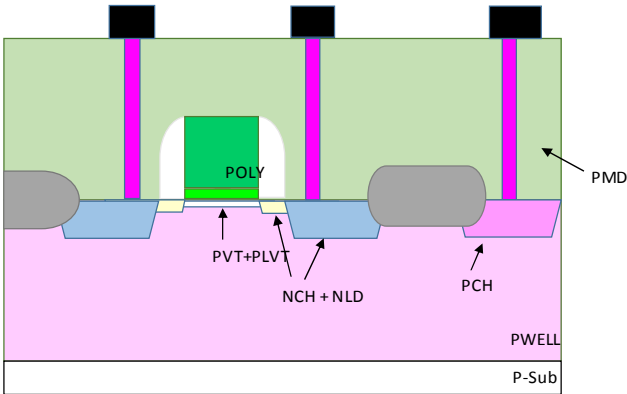
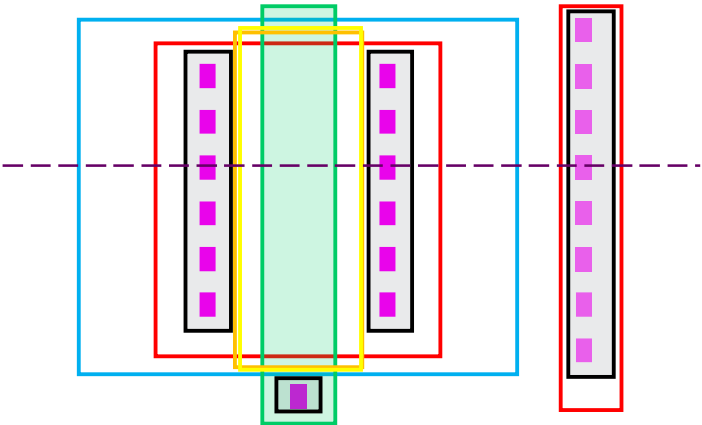


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	12 /48

MNH(5V Nch High Vt)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

- AA
- PVT
- PLVT
- POLY
- NCH+NLD
- CONT
- 1METAL

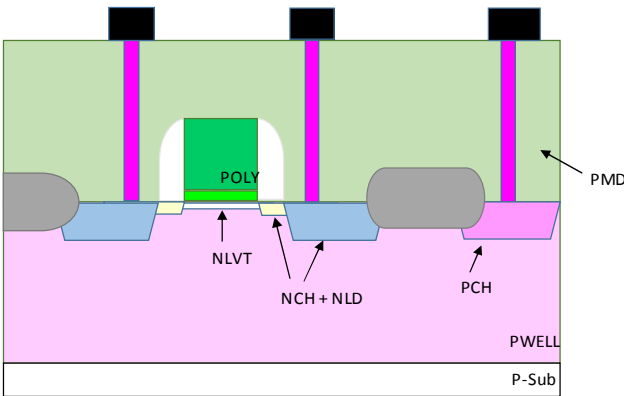
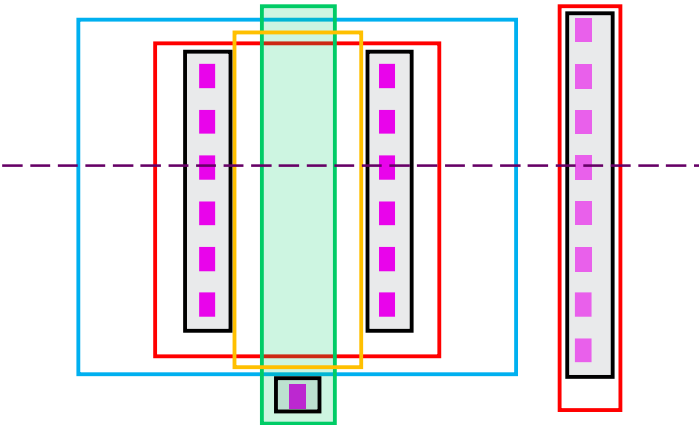


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	13 /48

MNL(5V Nch Low Vt)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

- AA
- NLVT
- POLY
- NCH+NLD
- CONT
- 1METAL

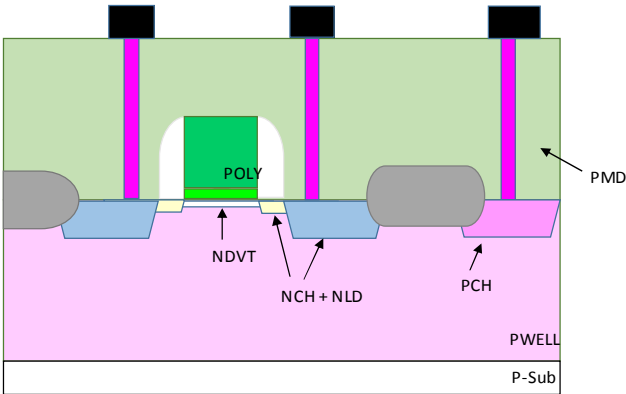
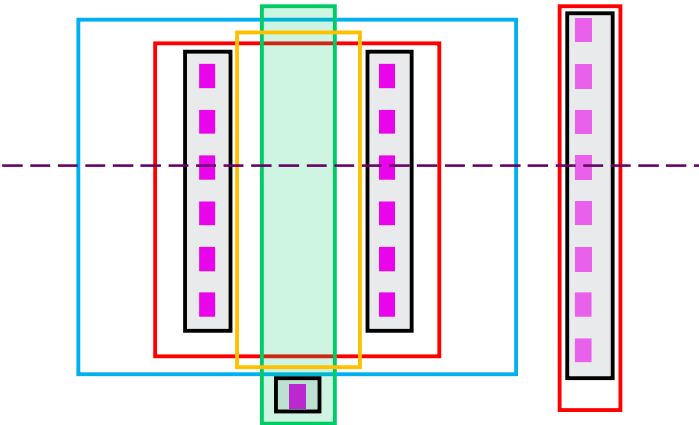


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	14 /48

MND(5V Nch Depletion Vt)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

- AA
- NDVT
- POLY
- NCH+NLD
- CONT
- 1METAL

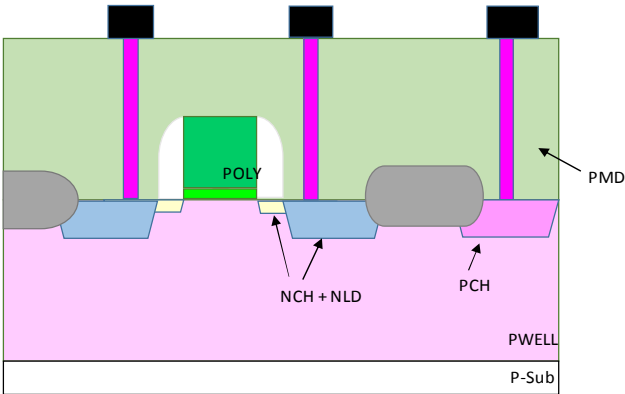
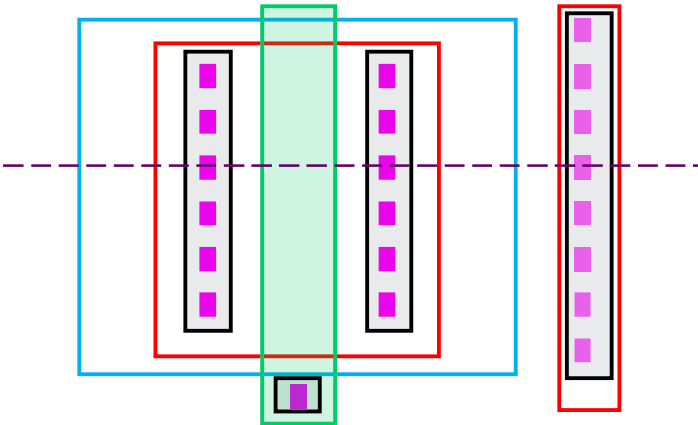


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	15 /48

MNN(5V Nch Native Vt)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

- AA
- POLY
- NCH+NLD
- CONT
- 1METAL

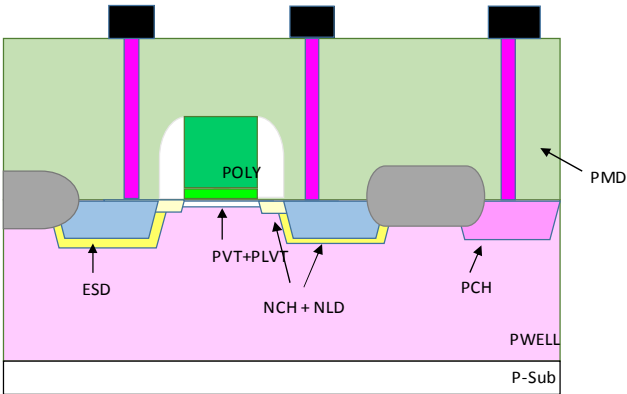
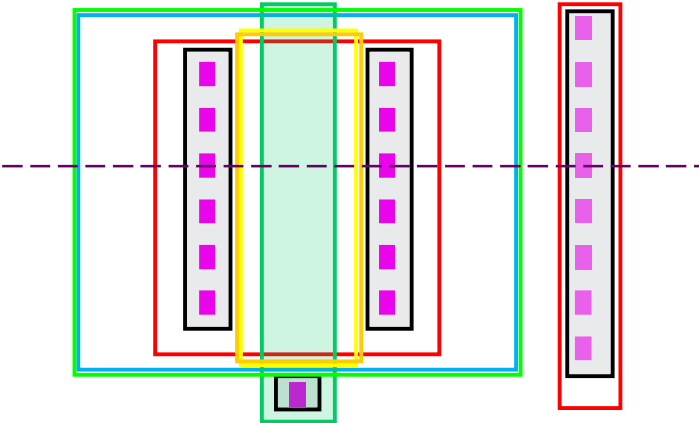


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	16 /48

MNE_LC, MNE_PC(5V Nch Esd protection /8finger, 10finger)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

- AA
- PVT
- PLVT
- POLY
- NCH+NLD
- ESD
- CONT
- 1METAL

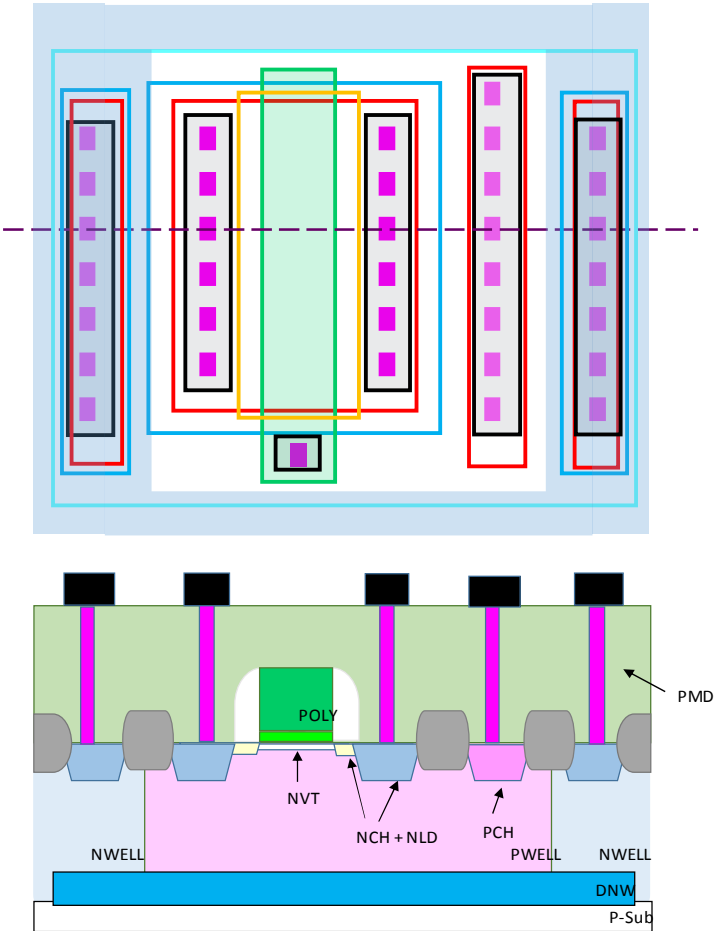


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	17 /48

MNMI(5V Nch Medium Vt Iso)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

DNW
NWELL
AA
NVT
POLY
NCH+NLD
CONT
1METAL

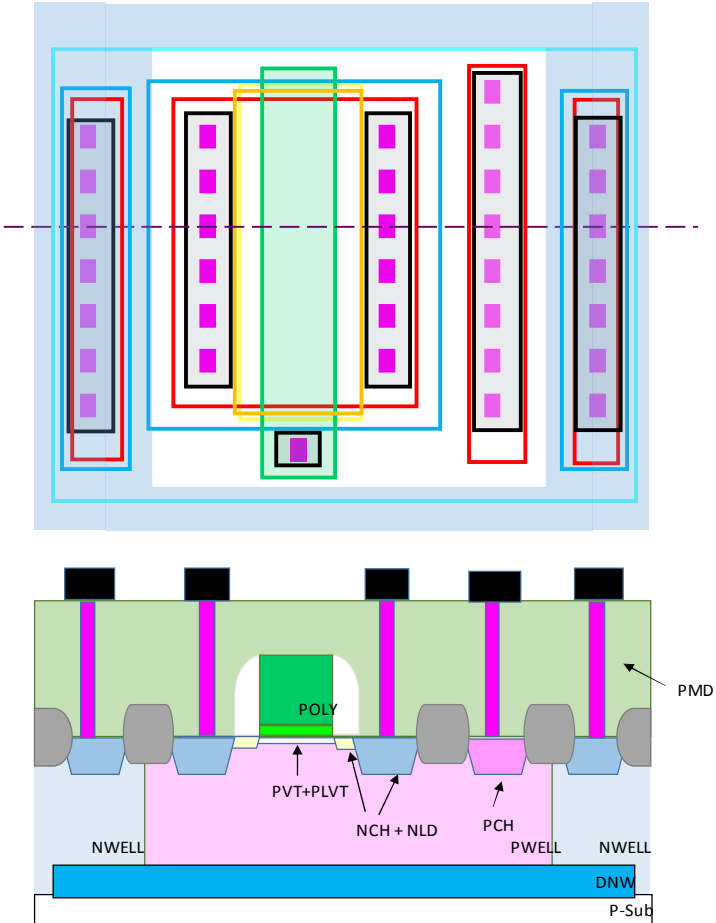


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	18 /48

MNHI(5V Nch High Vt Iso)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

DNW
NWELL
AA
PVT
PLVT
POLY
NCH+NLD
CONT
1METAL

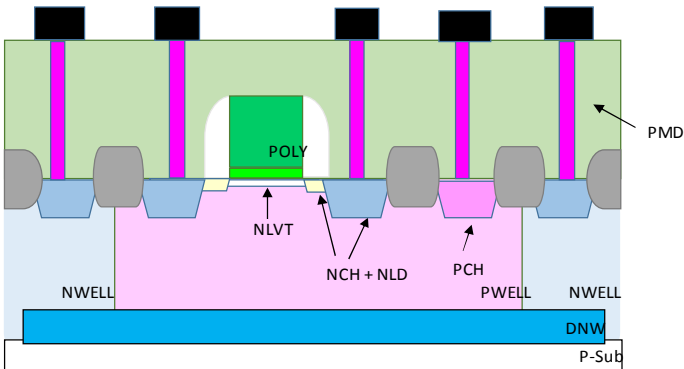
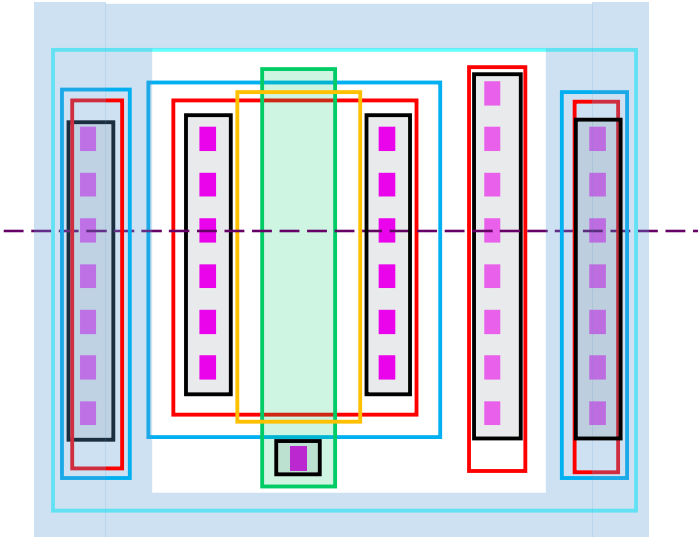


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	19 /48

MNLI(5V Nch Low Vt Iso)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

DNW
NWELL
AA
NLVT
POLY
NCH+NLD
CONT
1METAL

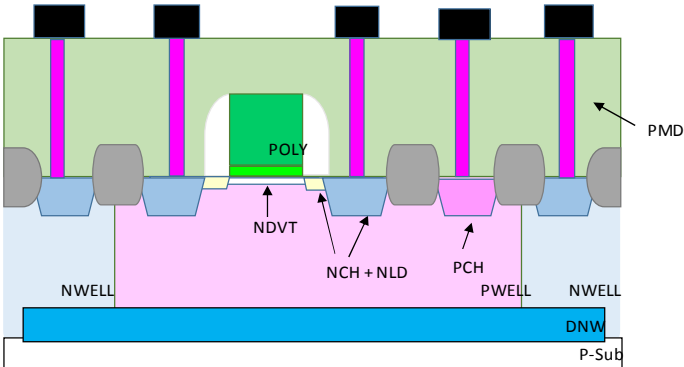
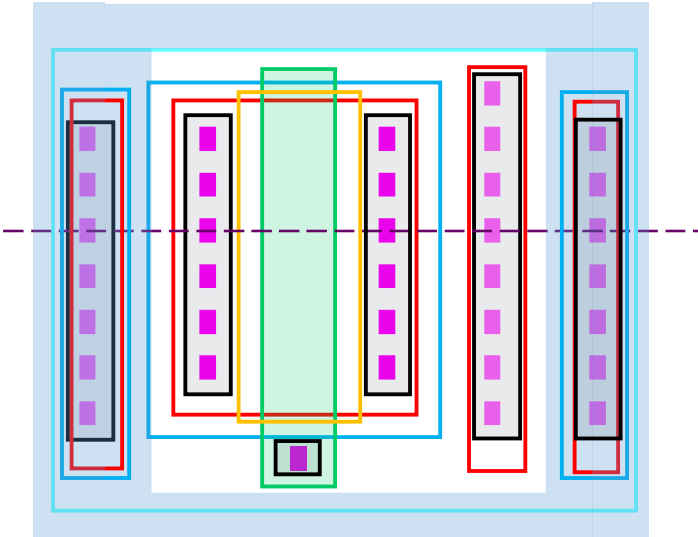


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	20 /48

MNDI(5V Nch Depletion Vt Iso)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

- DNW
- NWELL
- AA
- NDVT
- POLY
- NCH+NLD
- CONT
- 1METAL

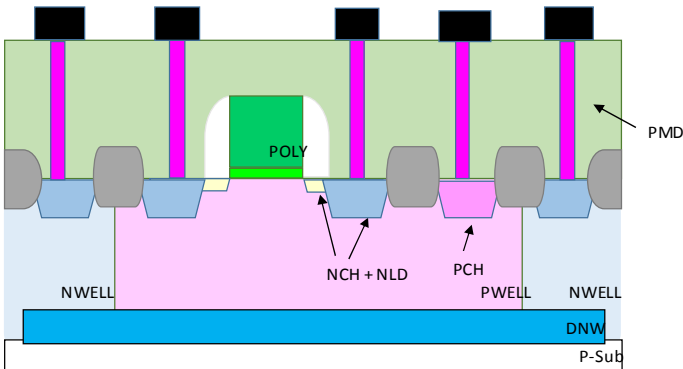
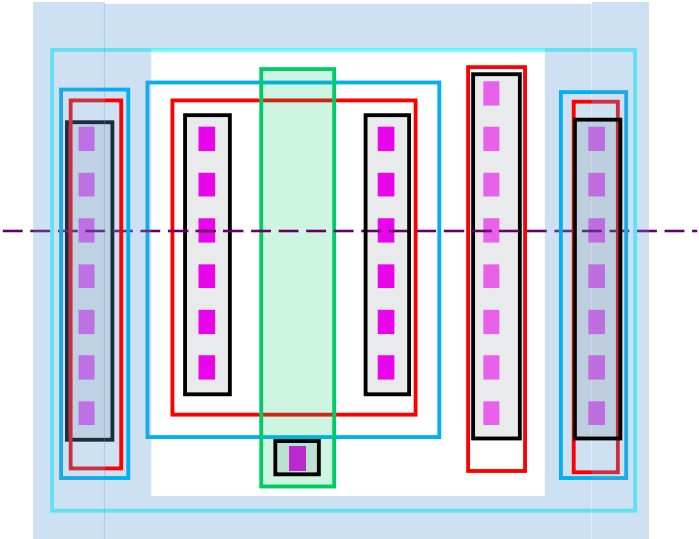


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	21 /48

MNNI(5V Nch Native Vt Iso)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

DNW
NWELL
AA
POLY
NCH+NLD
CONT
1METAL

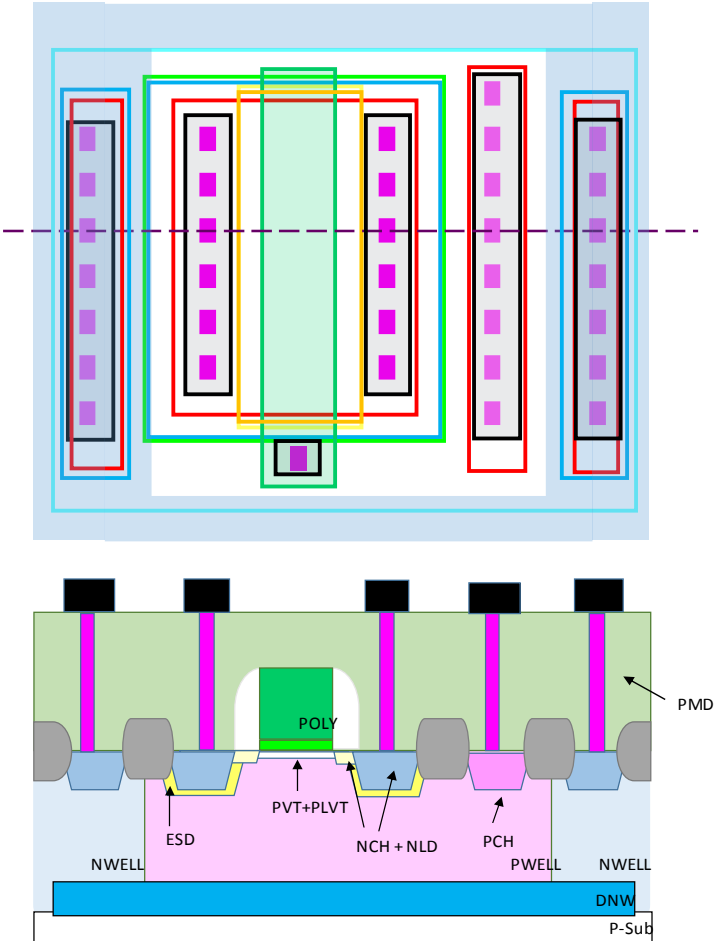


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	22 /48

MNEI_LC, MNEI_PC(5V Nch Esd protection Iso /8finger, 10finger)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		

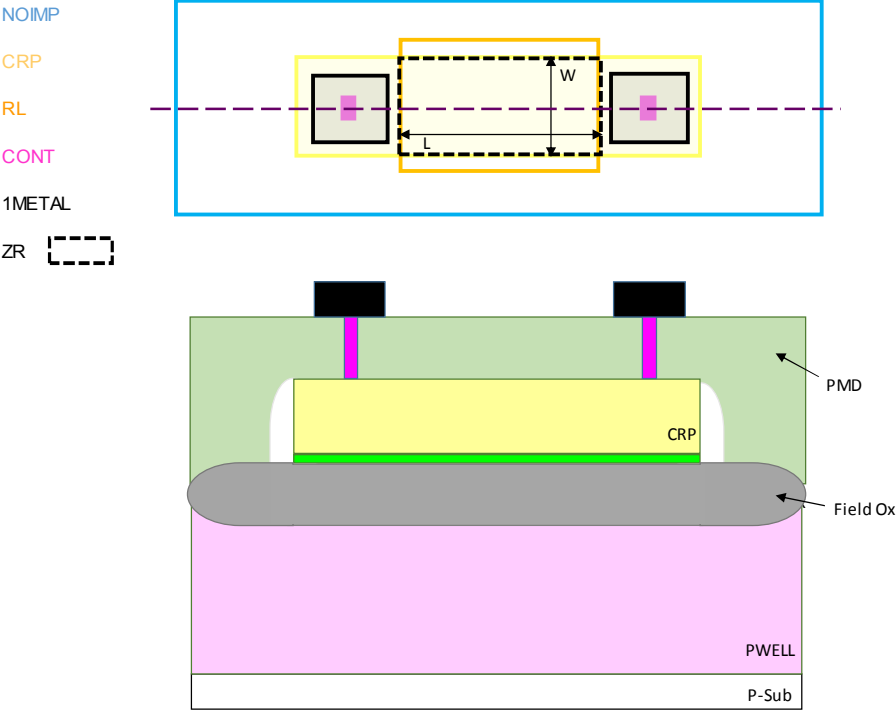
- DNW
- NWELL
- AA
- PVT
- PLVT
- POLY
- NCH+NLD
- ESD
- CONT
- 1METAL



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	23 /48

RPL(Low Resistance Poly-Si Resistor【95Ω/s】)

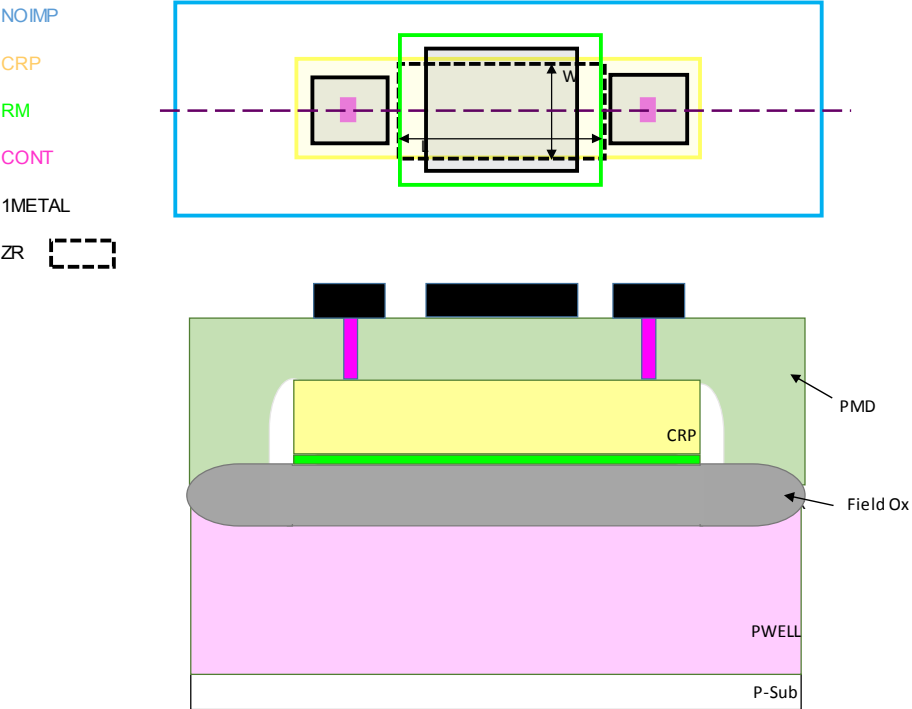
Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZR	75			



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	24 /48

RPM(Medium Resistance Poly-Si Resistor【330Ω/s】)

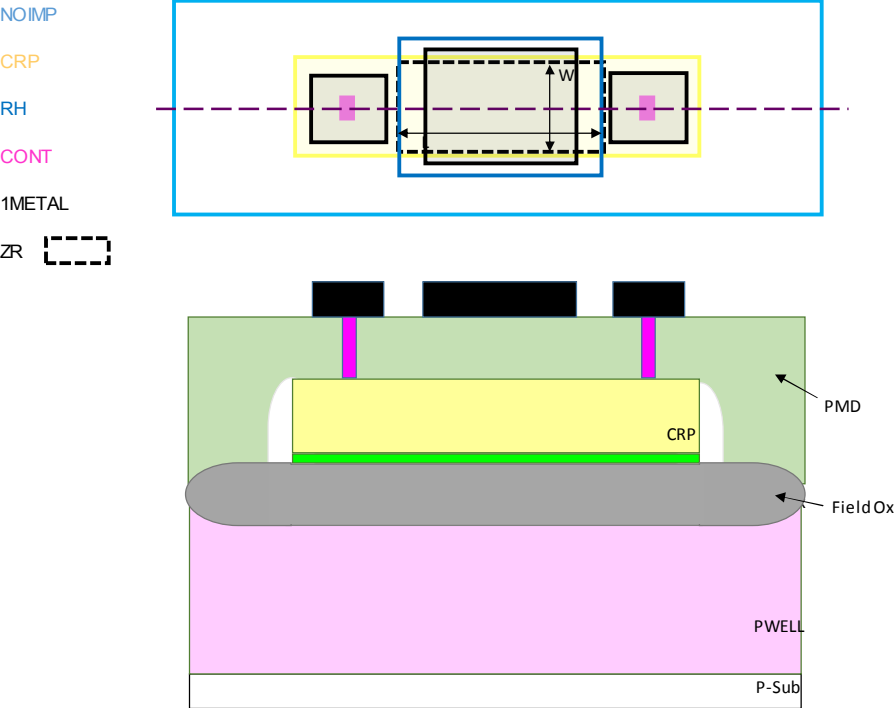
Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZR	75			



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	25 /48

RPH, RPH2(High Resistance Poly-Si Resistor【5kΩ/s】 , 【8kΩ/s】)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZR	75			



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	26 /48

RNW(Nwell Diff. Resistor)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZR	75			

NWELL

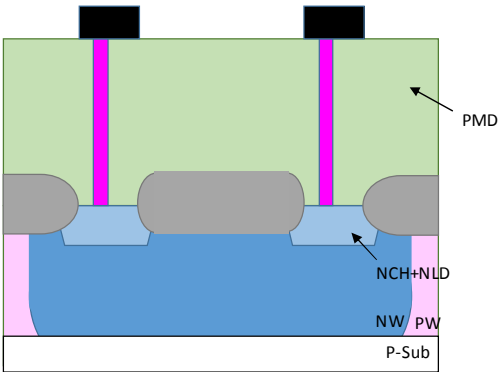
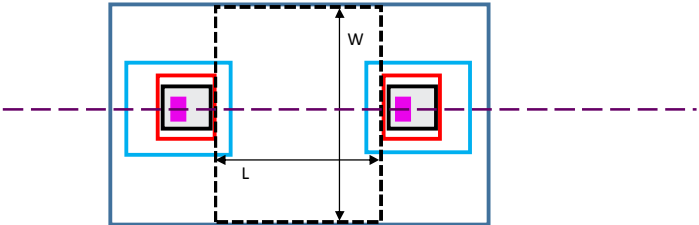
AA

NCH+NLD

CONT

1METAL

ZR 



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	27 /48

RN(N+ Diff. Resistor)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZR	75			

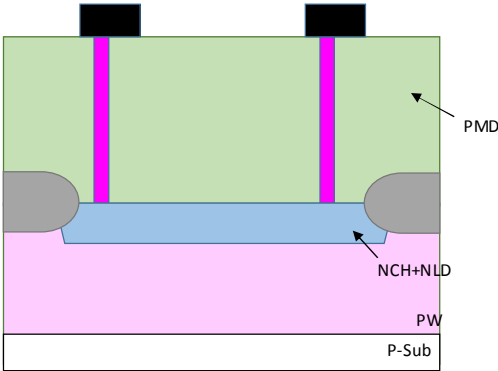
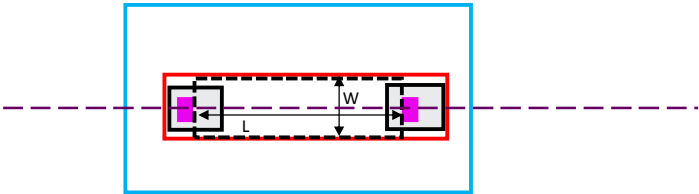
AA

NCH+NLD

CONT

1METAL

ZR 



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	28 /48

RP(P+ Diff. Resistor)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZR	75			

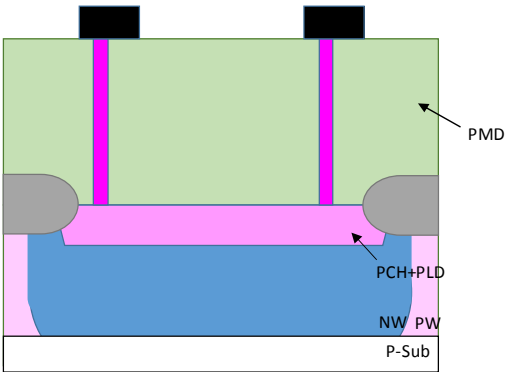
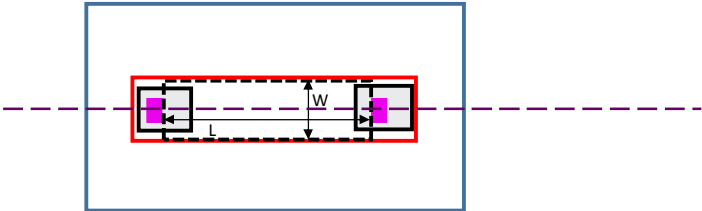
NWELL

AA

CONT

1METAL

ZR 



CPIP(PIP Capacitor)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	Don't Care
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZC	76			

CRP

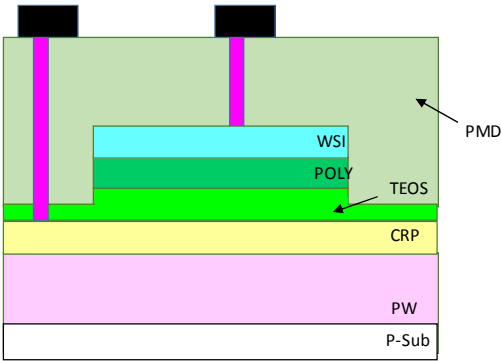
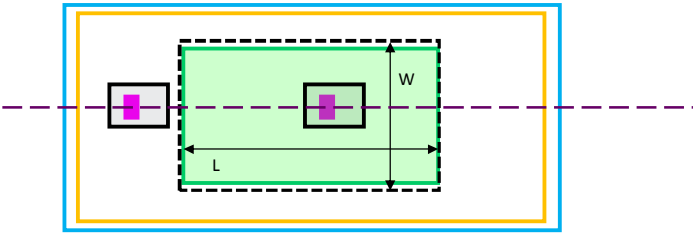
POLY

NCH+NLD

CONT

1METAL

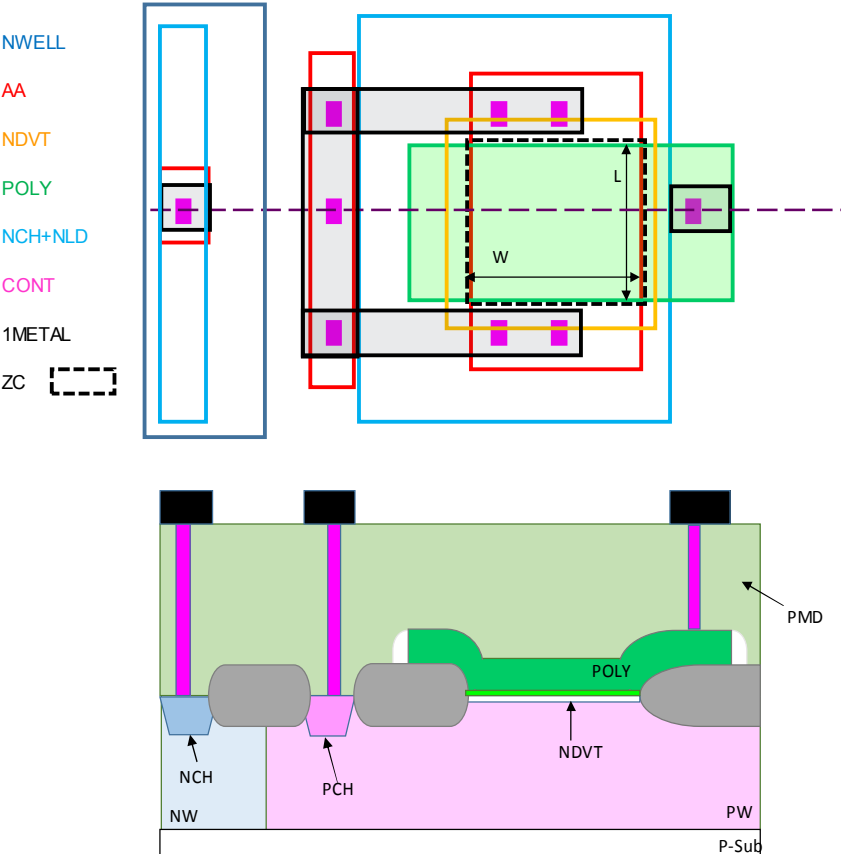
ZC



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	30 /48

CND(Nch Depletion Vt Capacitor)

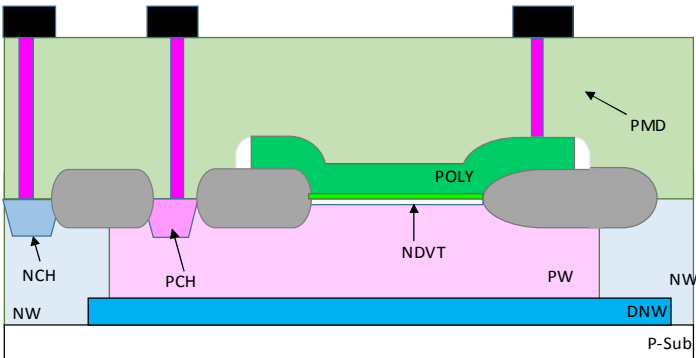
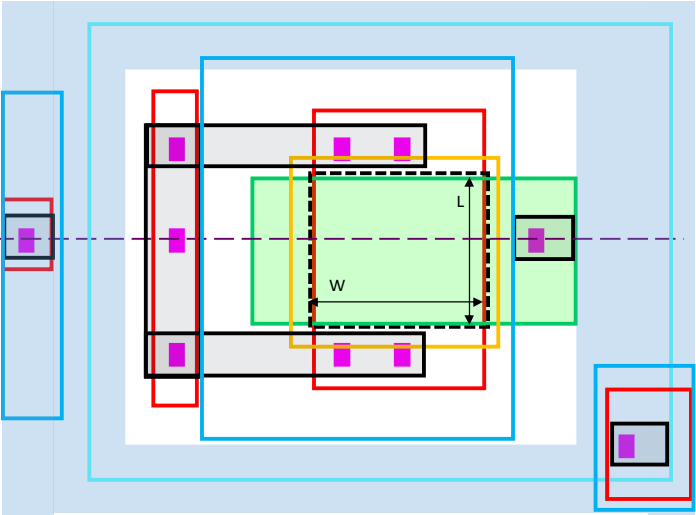
Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZC	76			



CNDI(Iso Nch Depletion Vt Capacitor)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZC	76			

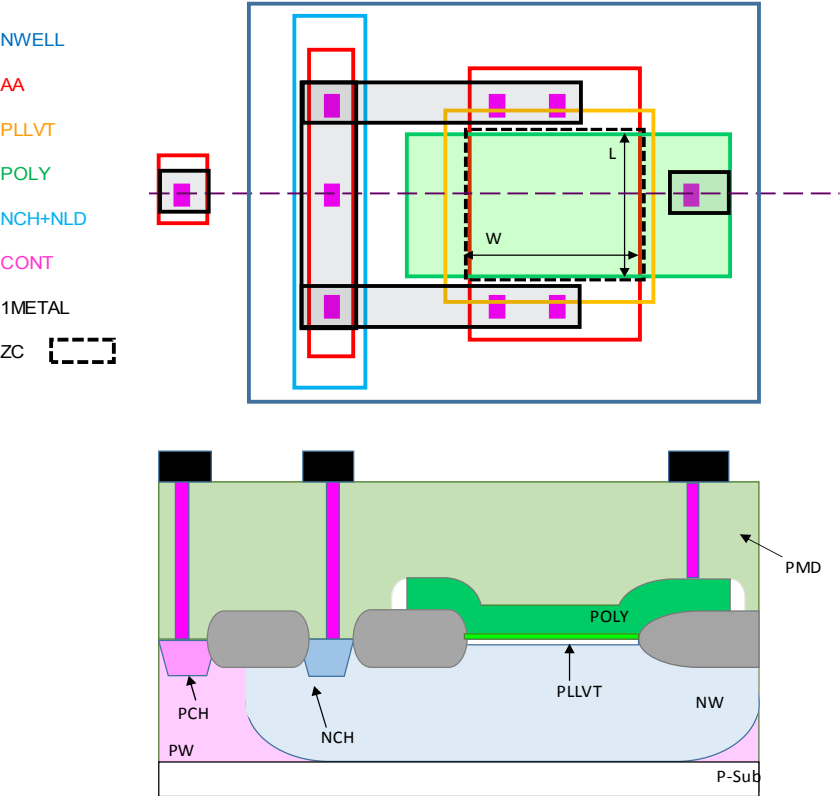
DNW
NWELL
AA
NDVT
POLY
NCH+NLD
CONT
1METAL
ZC



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	32 /48

CPL2(Pch Very Low Vt Capacitor)

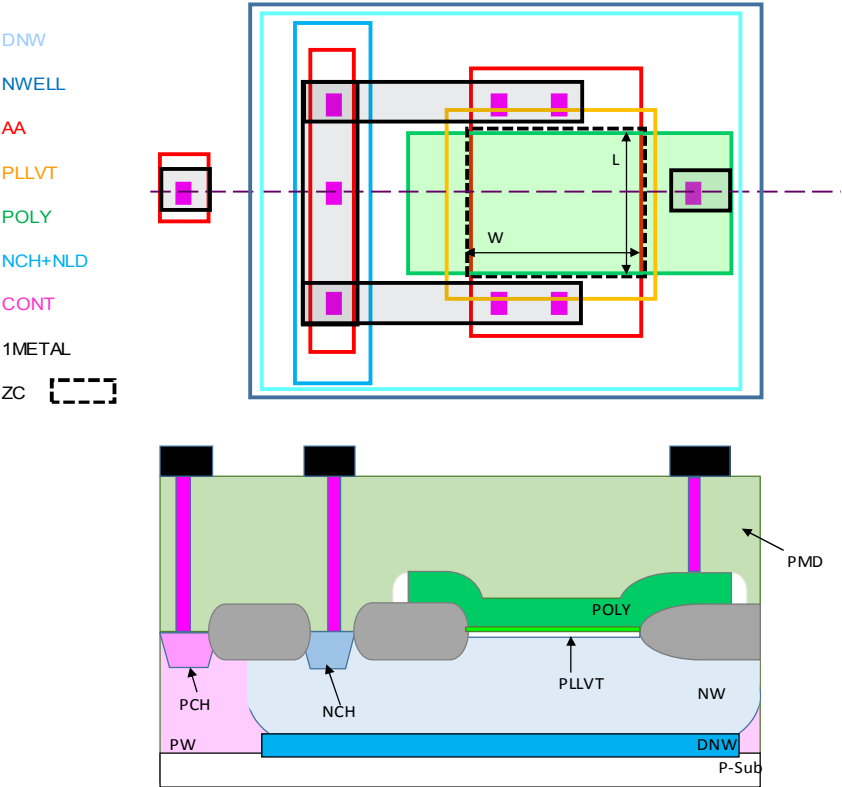
Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZC	76			



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	33 /48

CPL2I(Iso Pch Very Low Vt Capacitor)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZC	76			



PNP(Vertical PNP (P+/Nwell/Psub))

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZB	74			

NWELL

AA

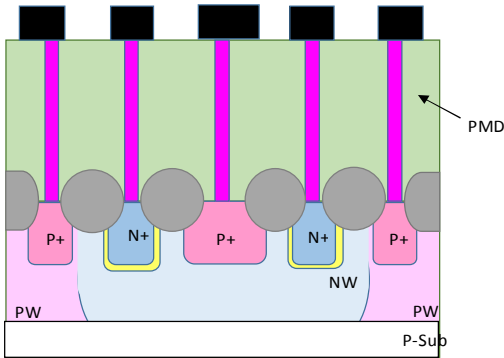
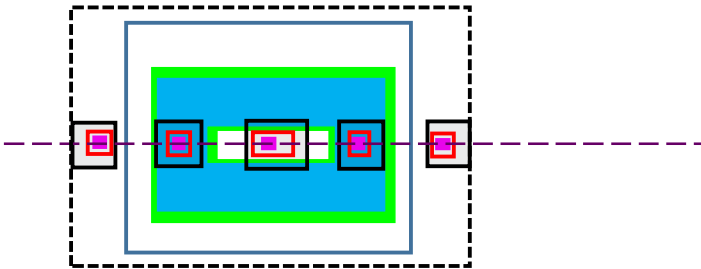
NCH+NLD

ESD

CONT

1METAL

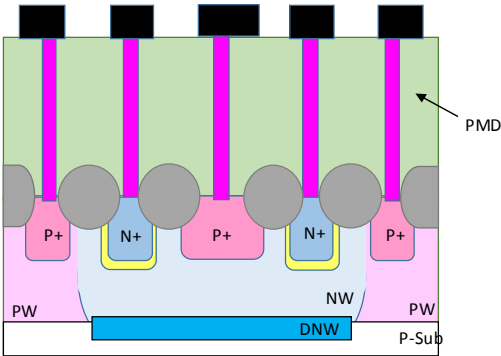
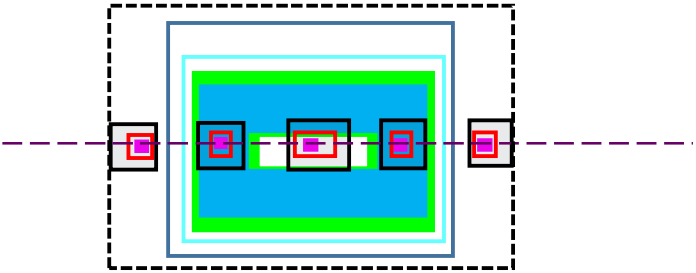
ZB



PNP2(Vertical PNP (P+/Nwell+DNW/Psub))

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZB	74			

DNW
NWELL
AA
NCH+NLD
ESD
CONT
1METAL
ZB



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	36 /48

NPN(Vertical NPN (N+/Pwell/DNW))

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWEELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZB	74			

DNW

NWELL

AA

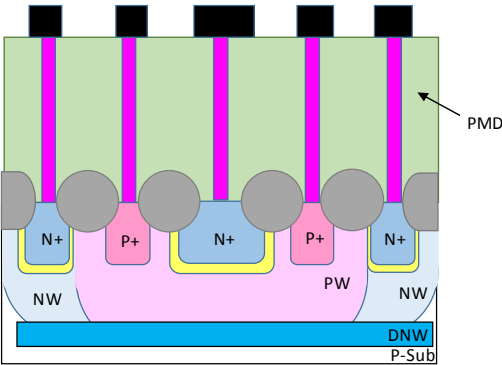
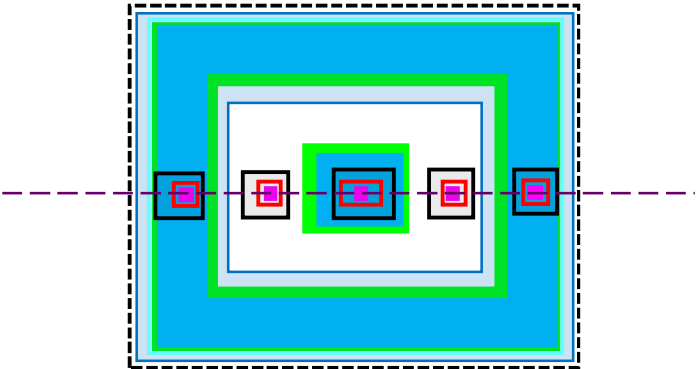
NCH+NLD

ESD

CONT

1METAL

ZB

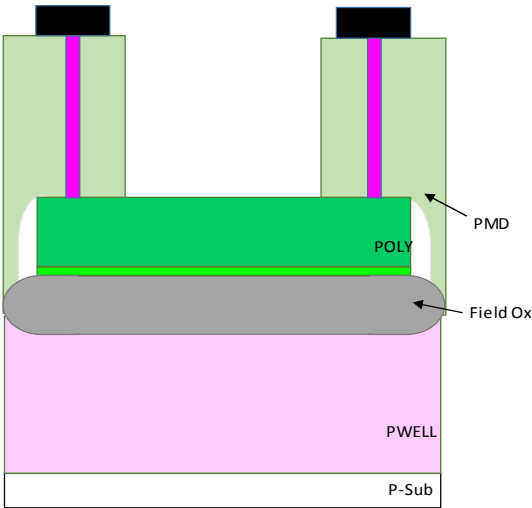
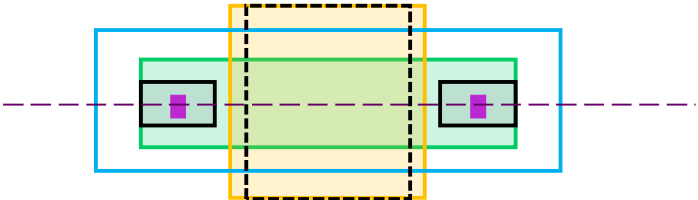


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	37 /48

RFS(Poly-Si Laser Trimming Fuse)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZR	75			

- NOIMP
- FUSE
- POLY
- CONT
- 1METAL
- ZR 



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	38 /48

DP(P+/Nwell Diode)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZD	73			

NWELL

AA

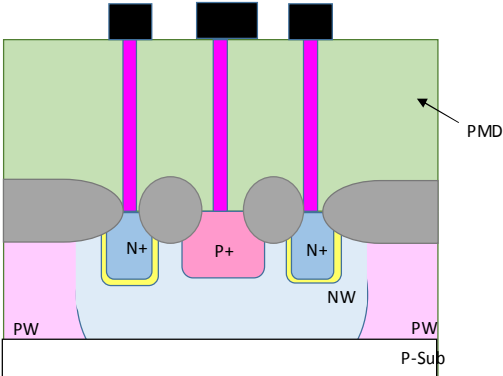
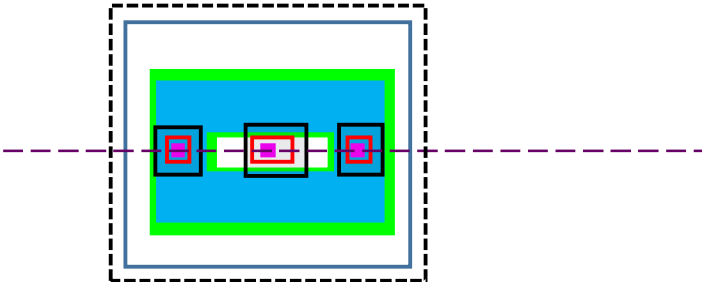
NCH+NLD

ESD

CONT

1METAL

ZD



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	39 /48

DP2(P+/Nwell in Niso Diode)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZD	73			

DNW

NWELL

AA

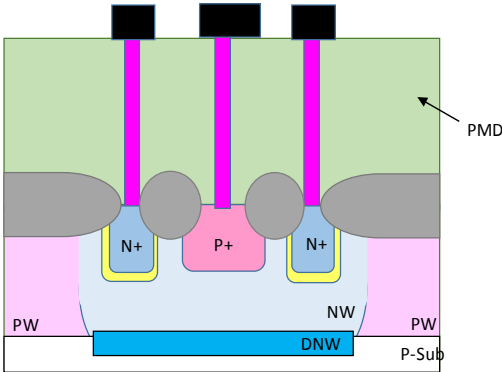
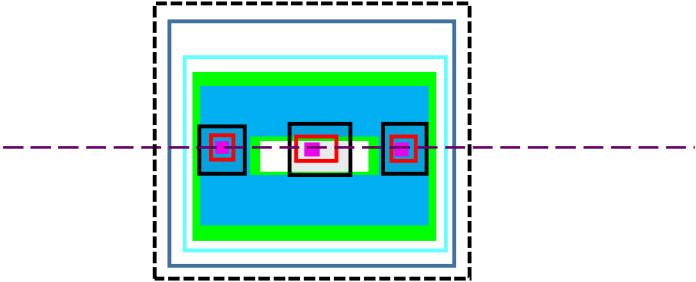
NCH+NLD

ESD

CONT

1METAL

ZD

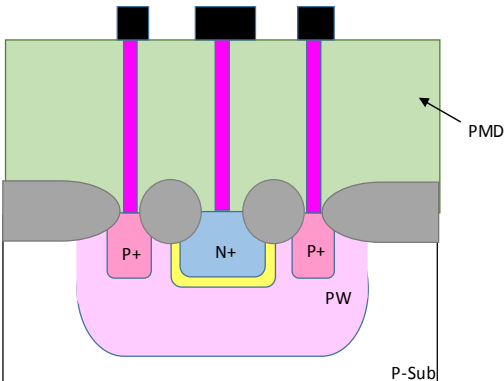
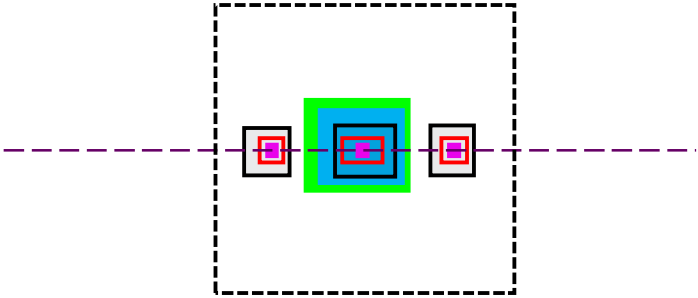


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	40 /48

DN(N+/Pwell Diode)

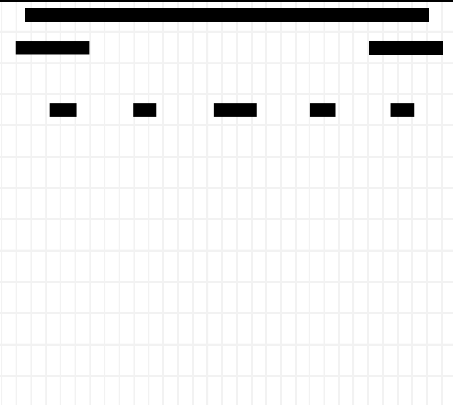
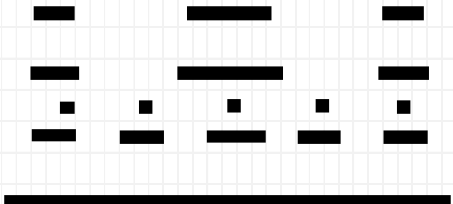
Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZD	73			

- AA
- NCH+NLD
- ESD
- CONT
- 1METAL
- ZD 

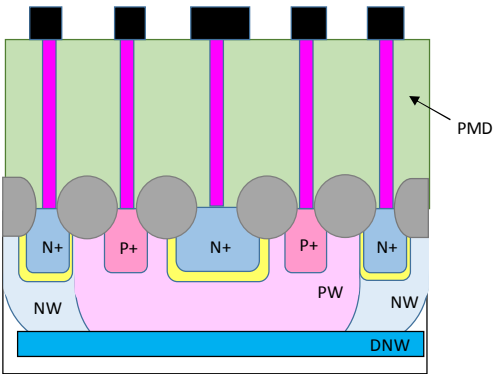
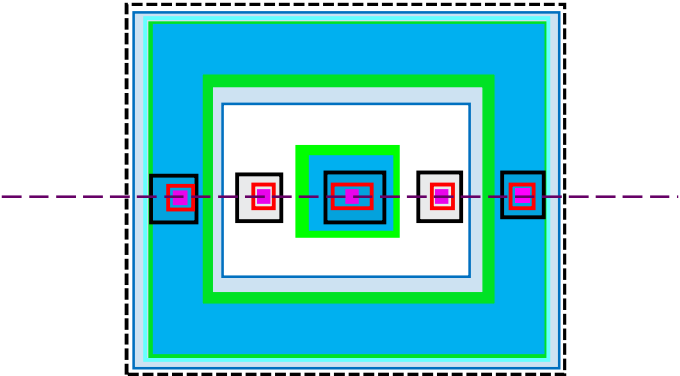


Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	41 /48

DN2(N+/Pwell in Niso Diode)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		
FUSE	46	反		
ZD	73			

- DNW
- NWELL
- AA
- NCH+NLD
- ESD
- CONT
- 1METAL
- ZD



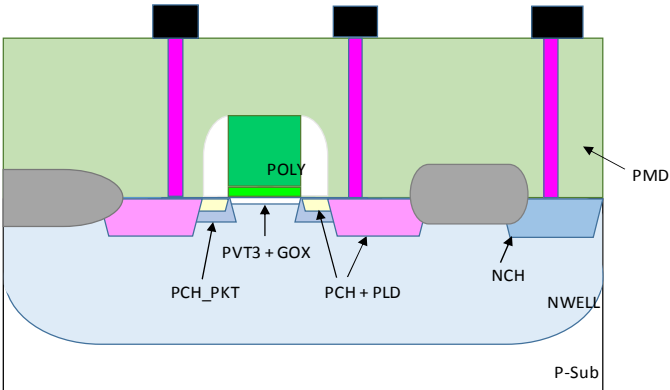
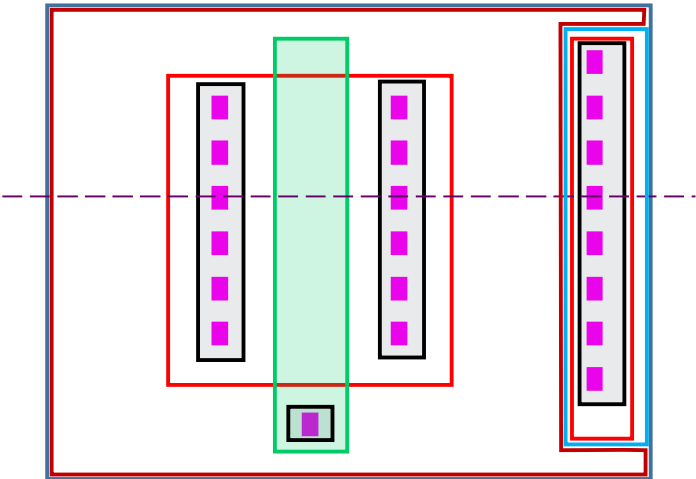
Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	42 /48

P (3.3V Pch MOS)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
PL3 (*1)	26	反	PVT3 IMP PPKT IMP	
NL3 (*1)	24	反	NPKT IMP NLD3 IMP	
GO	23	正	GOX IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18	-		
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		

(*1) GDSデータは演算で生成。

- NWELL
- AA
- POLY
- PL3
- NCH+NLD+NL3
- CONT
- 1METAL



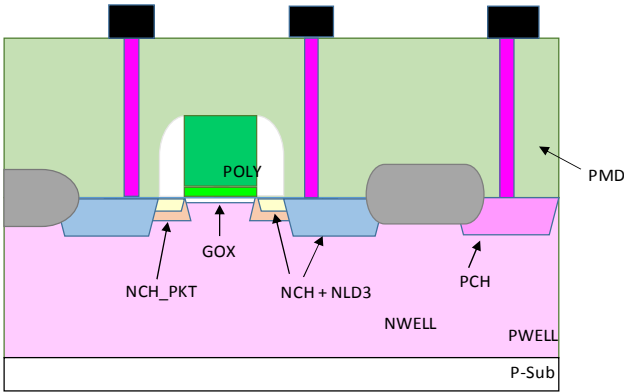
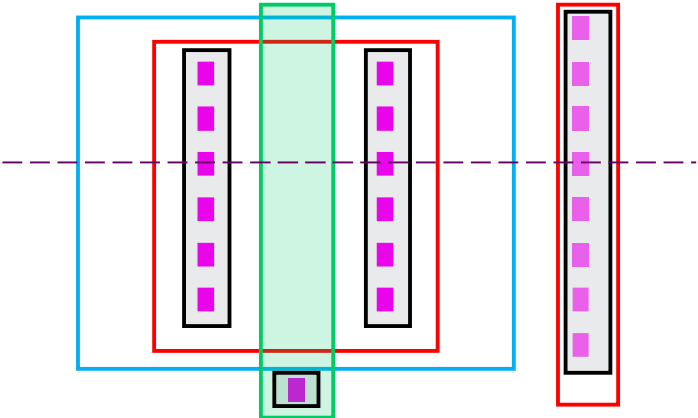
Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	43 /48

N (3.3V Nch MOS)

Layer	GDS No.	マスク 正反	工程名称	レイアウトデータ
DNW	20	反	DNW IMP	
NWELL	3	反	NWEL IMP	
PWELL	4	正	PWEL IMP	
AA	1	正		
PVT	48	反	PVT IMP	
PLVT	47	反	PLVT IMP	
PLLVT	84	反	PLLVT IMP	
NVT	49	反	NVT IMP	
NLVT	50	反	NLVT IMP	
NDVT	51	反	NDVT IMP	
PL3 (*1)	26	反	PVT3 IMP PPKT IMP	
NL3 (*1)	24	反	NPKT IMP NLD3 IMP	
GO	23	正	GOX IMP	
RH	19	正	MRPA IMP	
RM	65	正	MRPB IMP	
RL	66	正	LRPA IMP	
NOIMP	18			
CRP	17	正		
POLY	7	正		
NCH(NLD)	6	反	NSD1 IMP	
PCH(PLD)	5	正	PSD IMP	
ESD	71	反	NSD2 IMP	
CONT	8	反		
1METAL	9	正		

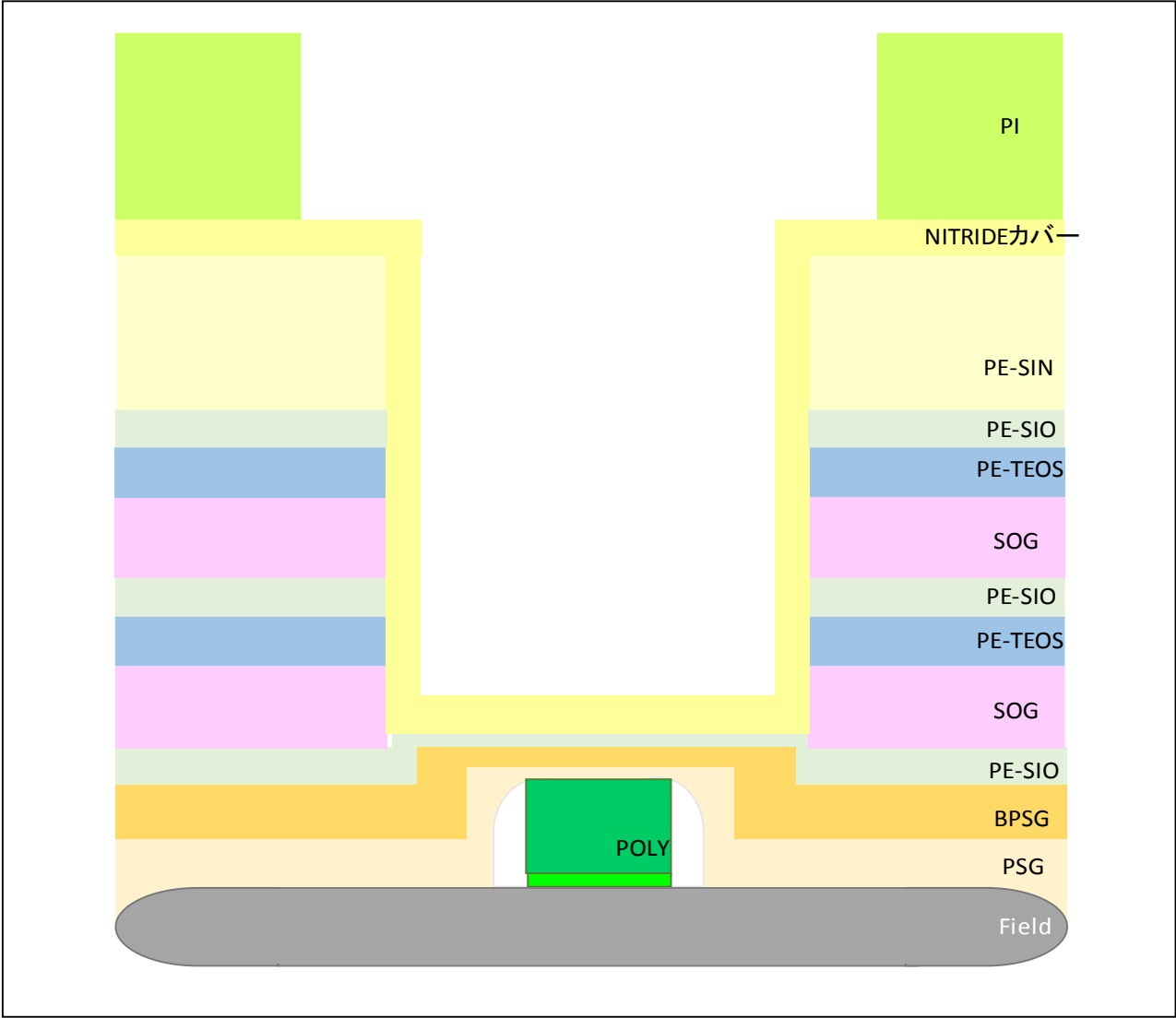
(*1) GDSデータは演算で生成。

- AA
- POLY
- NCH+NLD+NL3
- CONT
- 1METAL



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	44 /48

3. Fuse Opening-part Cross section



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	45 /48

4. Relation between Mask and Implant for CRP (1st Poly-Si)

[Matrix of Mask and Implant for each device area]

Process Name	Layer Composition	Mask Dark/ Clear	Poly-Si Resistor				PIP Capacitor Bottom plate	Gate-Poly (1st Poly-Si)
			Body area			Tap area		
			RPH/RPH2	RPM	RPL			
HR Impl	(Blanket Implant)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MRPA Mask	RH	Dark	chrome					
MRPA Impl	-	-	X	✓	✓	✓	✓	✓
MRPB Mask	RH+RM	Dark	chrome	chrome				
MRPB Impl	-	-	X	X	✓	✓	✓	✓
LRPA Mask	RH+RM+RL	Dark	chrome	chrome	chrome			
LRPA Impl	-	-	X	X	X	✓	✓	✓

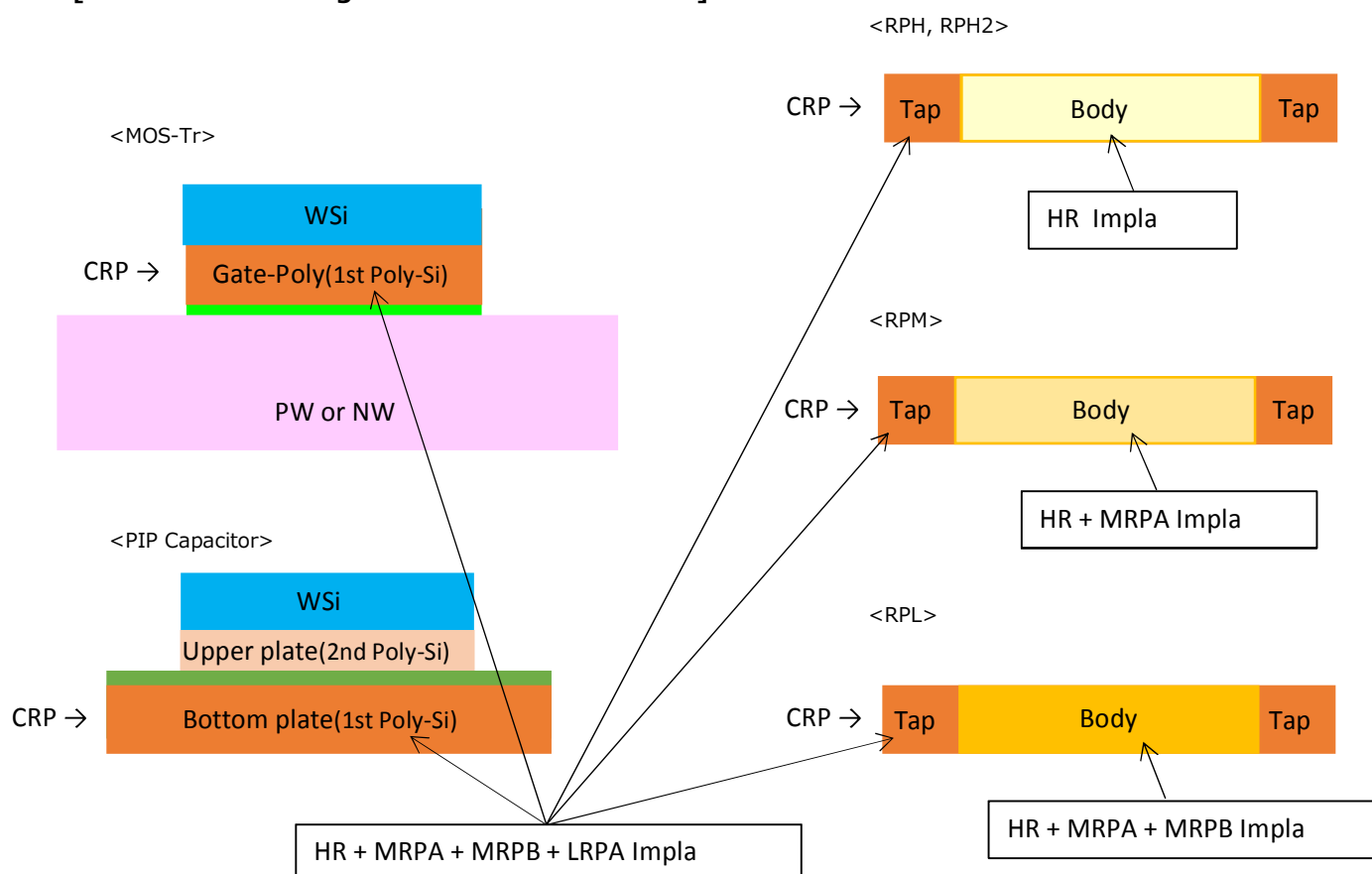
Impurity Concentration → Lower ← Higher

Poly Sheet Resistance → Higher ← Lower

***Notation**

✓	Implanted	chrome	chrome on Mask	-	N/A
X	Not Implanted		No chrome on Mask		

[Cross sectional diagrams for CRP used device]



Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	46 /48

制定日 Rev.0.0	2016.11.30
----------------	-------------------

保管先	技術グループ PDKプロジェクト
-----	------------------







Approval	Check	Issue
		

4. Revision History

Rev.	Date	Description of change	Issue Check Approval
0.0	2016/11/30	•Initial Release	Akano
0.1	2017/5/16	•Layer_matrix delete	Mituzono
0.2	2017/7/26	Change Device description as following (whole pages) MOS-Tr, MOS-Cap; add "Vt" BJT •Vertical PNP (P+/Nwell+NIsopsub) -> (P+/Nwell+DNW/Psub) •Vertical NPN (N+/Pwell/NIso) -> (N+/Pwell/DNW) Poly Resistor •Low sheet Poly Resistor -> Low Resistance Poly-Si Resistor【95Ω/s】 •Medium sheet Poly Resistor -> Medium Resistance Poly-Si Resistor【330Ω/s】 •High sheet Poly Resistor【5kohm/sq】 -> High Resistance Poly-Si Resistor【5kΩ/s】 •High sheet Poly Resistor【8kohm/sq】 -> High Resistance Poly-Si Resistor【8kΩ/s】 Laser Poly Fuse •Fuse -> Poly-Si Laser Trimming Fuse MNE_LC, MNE_PC -> add "/8finger, 10finger" MNEI_LC, MNEI_PC -> add"/8finger, 10finger" Layer table •change order of layer PVT, RL, NOIMP, FUSE •add layer ZB for PNP, PNP2, NPN •add layer ZR for RFS •delete layer PMP, PPP RPM, RPH, RPH2 •add 1METAL cover P.3 add Chapter name "2.Device Cross section" P.38 add Chapter name "3.Fuse Opening-part Cross section"	Kitagawa Ohkawa Kurihara







Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	47 /48

4. Revision History

Rev.	Date	Description of change	Issue Check Approval
0.3	2017/08/17	<p>All pages Change format of header name → Document name control number → Document number ver → Rev.</p> <p>4.Rev.his.(2) Page addition. (total pages 39 → 40)</p>	<p>Ohkawa</p>  <p>Kitagawa</p>  <p>Kurihara</p> 
0.4	2017/12/07	<p>p.1, Contents</p> <ul style="list-style-type: none"> •Add 4. Relation between Mask and Implant for CRP (1st Poly-Si) •change 4. Revision History -> 5. Revision History <p>p.39, Relation between Mask and Implant for CRP (1st Poly-Si)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Add "sheet" Implant matrix table and cross sectional diagrams for CRP used device <p>Total page 40 -> 41</p>	<p>Kitagawa</p>  <p>Akano</p>  <p>Kurihara</p> 

Document name	Document number	Rev.	Page
PK35 Device Structure	DS2-001	1.0	48 /48

4. Revision History

Rev.	Date	Description of change	Issue Check Approval
0.5	2018/02/16	MOS (excluding native Vt MOS) and all MOS_Capacitor. Illustration correction. (VIMP enclosure of "AA" → "gate") 4.Rev.his.(3) Page addition. (total pages 41 → 42)	Ohkawa Kitagawa Kurihara
0.6	2018/03/16	cover(P.0) Total Page 42 → 46 contents(P.1) add DP, DP2, DN, DN2 DP(P+/Nwell Diode) (P.38) sheet addition DP2(P+/Nwell in Niso Diode) (P.39) sheet addition DN(N+/Pwell Diode) (P.40) sheet addition DN2(N+/Pwell in Niso Diode) (P.41) sheet addition Change "工程名称" : I2 -> IMP	Mitsuzono  Kitagawa  Kurihara 
1.0	2019/09/06	■ Upgraded Rev.0.6 to Rev.1.0 by adding 3.3V_MOS. cover(P.0) Total Page 46 → 48 contents(P.1) add "5V" to description of all 5V_MOS. add 3V_MOS (P, N). P.3 ~ P.22 add "5V" to description of all 5V_MOS. P (3.3V Pch MOS) (P.42) sheet addition N (3.3V Nch MOS) (P.43) sheet addition	Ohkawa  Kitagawa  Takenaka  Kurihara 